

EUROPEAN PATENT OFFICE

Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 63244768
PUBLICATION DATE : 12-10-88

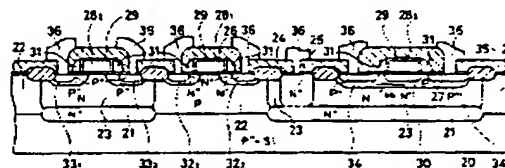
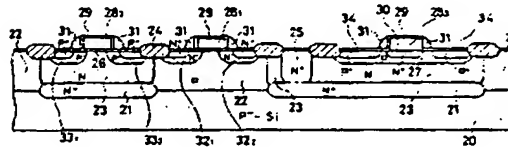
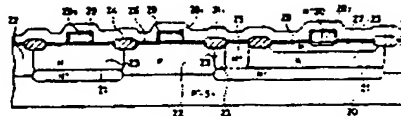
APPLICATION DATE : 31-03-87
APPLICATION NUMBER : 62078567

APPLICANT : TOSHIBA CORP;

INVENTOR : SHINADA KAZUYOSHI;

INT.CL. : H01L 27/06 H01L 29/72

TITLE : BIPOLAR CMOS TYPE
SEMICONDUCTOR DEVICE AND
MANUFACTURE THEREOF



ABSTRACT : PURPOSE: To speed up operations by a method wherein an emitter electrode is built in an emitter region on a semiconductor substrate and the emitter electrode is equipped with side walls.

CONSTITUTION: A diffusion region 21 is provided in a substrate 20 of the plane orientation (100), after which a P-type epitaxial layer 22 is allowed to grow. Next, after the formation of a diffusion region 23, an oxide film 24 is formed, and then a diffusion region 25 is formed so deep as to reach the diffusion region 21. A thermal oxide film 26 is formed, B⁺ ions are implanted, and a heat treatment is accomplished. A part of the film 26 positioned on a region 27 is allowed to peel off, a polycrystalline silicon film 28 is deposited, and then As⁺ ions are implanted. A process follows wherein the polycrystalline silicon film 28 is patterned for the construction of electrodes 28₁, 28₂, and 28₃, after which a thermal oxide film 29 is formed, when As diffusing out of an emitter electrode results in an emitter region 30. Ions P⁺ and then B⁺ are implanted for the realization of a high voltage withstanding structure. A CVD oxide film 31 is deposited, which is next etched back for partial retention. Implantation is accomplished of As⁺ and BF₃, which is followed by a heat treatment whereby source and drain regions 32₁, 32₂, 33₁, 33₂ and a base region 34 are formed. A passivation film 35 is deposited, and an electrode 36 is built. In this way, base resistance just under the emitter region may be reduced.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

93 7

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁(JP) ⑪ 特許出願公開
⑫ 公開特許公報(A) 昭63-244768

⑬ Int. Cl.⁴ 識別記号 庁内整理番号 ⑭ 公開 昭和63年(1988)10月12日
H 01 L 27/06 3 2 1 7735-5F
29/72 8526-5F
審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

⑮ 発明の名称 バイポーラーCMOS型半導体装置及びその製造方法

⑯ 特 願 昭62-78567

⑰ 出 願 昭62(1987)3月31日

⑱ 発 明 者 品 田 一 義 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝多摩
川工場内

⑲ 出 願 人 株 式 会 社 東 芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

⑳ 代 理 人 弁理士 鈴 江 武 彦 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

バイポーラーCMOS型半導体装置及びその製造方法

2. 特許請求の範囲

同一半導体基板上に、MOS型トランジスタとバイポーラ型トランジスタとを有するバイポーラーCMOS型半導体装置において、

上記半導体基板のエミッタ領域上に形成されたエミッタ電極と、

このエミッタ電極の側壁に絶縁膜によって形成されたサイドウォールとを上記バイポーラ型トランジスタが有することを特徴とするバイポーラーCMOS型半導体装置。

(2) 上記MOS型トランジスタは、上記半導体基板上に絶縁膜を介して形成されたゲート電極と、

このゲート電極の側壁に絶縁材によって形成されたサイドウォールとを有することを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のバイポーラーCMOS型半導体装置。

(3) コレクタ領域及び内部ベース領域が形成さ

れた半導体基板上にポリシリコン膜を形成する第1の工程と、

この第1の工程によって形成されたポリシリコン膜をエッチングしてエミッタ電極を形成する第2の工程と、

この第2の工程によって形成されたエミッタ電極を被うように、上記半導体基板上に絶縁膜を形成する第3の工程と、

この第3の工程によって形成された絶縁膜の上に配化膜を形成する第4の工程と、

この第4の工程によって形成された酸化膜をエッチバックして上記エミッタ電極の側壁にサイドウォールを形成する第5の工程と、

上記半導体基板に不純物をイオン注入した後、熱処理することにより、この半導体基板に外部ベース領域を形成する第6の工程とによってバイポーラ型トランジスタが形成されることを特徴とするバイポーラーCMOS型半導体装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は、バイポーラーCMOS型の半導体装置及びその製造方法（以下、BI-CMOS型半導体装置と記す）に関する。

(従来の技術)

近年、半導体の技術分野においては、低消費電力化を図るために、半導体装置にCMOS回路を使うことが多くなってきた。また、最近では、単に低消費電力化を図るだけでなく、高速化を図るためにCMOS回路にバイポーラトランジスタを付加したBI-CMOS型半導体装置が注目されている。

従来、このBI-CMOS半導体装置は、第3図に示す製造工程に従って形成されていた。

まず、第3図(a)に示す工程においては、P型シリコン基板1に選択的にN⁺型埋込拡散領域2を設けた後、気相成長法にてP型エピタキシャル層(Pepi)3を形成する。次にN⁺型埋込拡散領域2に連するよう、NPNバイポーラトランジスタのコレクタ領域となるNウェル拡散層(NWell)4を設ける。続いて、フィールド酸化膜5を形成し、パ

最後に、第3図(d)に示す工程において、パッシベーション膜14を堆積した後、コンタクトを開孔し、さらにアルミニウム電極15を設けることにより、NMOS、PMOSトランジスタ及びNPNバイポーラトランジスタが同一半導体基板1上に完成する。

以上述べたように従来は、BI-CMOS半導体装置を製造するのに、CMOSトランジスタの製造プロセス中で、バイポーラトランジスタを製造するようになっている。

しかし、従来は、P⁺型外部ベース領域13を非自己焼台(非セルフアライン)で形成するため、N⁺型エミッタ領域11下のベース抵抗 r_{bb}' (第3図(e)参照)が大きくなり、CMOS回路と同一の基板1上で、バイポーラトランジスタの高速動作を実現することが困難であった。

(発明が解決しようとする問題点)

以上述べたように、従来のBI-CMOS半導体装置においては、CMOS回路と同一半導体基板に高速動作可能なバイポーラトランジスタを搭載すると

バイポーラトランジスタを形成することになるNウェル拡散層4中に、N⁺型埋込拡散領域2に連するよう、深いN⁺型拡散領域6を形成する。N⁺型埋込拡散領域2、深いN⁺型拡散領域6は、NPNバイポーラトランジスタのコレクタ領域となるNウェル拡散層4の抵抗を低減するのに有効である。

第3図(b)に示す工程においては、ゲート酸化膜7を設け、B⁺の低ドーゾイオン注入により、P型内部ベース領域8を形成した後、Pドーブドポリシリコン膜9を堆積する。

第2図(c)工程においては、ポリシリコン膜9をRIE法にてパターニングして、NMOS及びPMOSトランジスタのゲート電極9₁、9₂を形成する。続いて、As⁺を高ドーゾイオン注入して、NMOSトランジスタのN⁺型ソース、ドレイン領域10₁、10₂及びNPNバイポーラトランジスタのN⁺エミッタ領域11を形成する。次に、B⁺を高ドーゾイオン注入してPMOSトランジスタのP⁺型ソース、ドレイン領域12₁、12₂及びNPNバイポーラトランジスタのP⁺型外部ベース領域13を形成する。

とが難しいという問題があった。

そこで、この発明は、CMOS回路と同一半導体基板に高速動作可能なバイポーラトランジスタを容易に搭載可能なBI-CMOS半導体装置及びその製造方法を提供することを目的とする。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

上記目的を達成するために、この発明は、半導体基板のエミッタ領域上にエミッタ電極を形成し、このエミッタ電極の側壁にサイドウォールを設けるようにしたものである。

(作用)

上記構成によれば、上記サイドウォールをスペーサとして、エミッタ領域に対して外部ベース領域をセルフアラインで形成することができるため、エミッタ領域下のベース抵抗を小さくすることができ、バイポーラトランジスタの高速動作を実現することができる。

(実施例)

以下、図面を参照してこの発明の実施例を詳

細に説明する。

第1図は一実施例の製造工程を示す図であるが、ここで、この第1図を説明する前に、第2図を使って一実施例の概略を説明する。

近年、LSIの進展に伴ない、MOSトランジスタの微細化が必須となり、MOSトランジスタのチャネル長がたとえば $0.8 \sim 1.2 \mu\text{m}$ と短くなる傾向にある。その結果、ショートチャネル効果、ホットエレクトロン耐性が厳しくなり、トランジスタの動作の信頼性が確保できなくなる傾向にある。

このため、第2図(a)に示す如く、P⁻型シリコン基板あるいはNウェル拡散層41上にゲート酸化膜42、A⁺又はPドープポリシリコンゲート電極43を設け、たとえば低ドーズP⁺あるいはB⁺イオン注入により、N⁻型あるいはP⁻型ソース、ドレイン領域44、45を形成した後、CVD酸化膜を堆積し、これをRIE法にてエッチバックしてポリシリコンゲートの側壁にのみCVD酸化膜46₁、46₂を残存させる。続いて、たとえば高ドーズA⁺あるいはBF₂⁺イオン注入により、N⁺型あるいはP⁺

型ソース、ドレイン領域47、48を形成するとにより、超LSIに適した信頼性あるNMOSあるいはPMOSトランジスタを備えたCMOS回路が提供される。

この実施例は、第2図(b)に示す如く、上記技術を用い、CMOS回路を形成した同一半導体基板上に略同一プロセスにより高導NPNバイポーラトランジスタを搭載するものである。すなわち、バイポーラトランジスタのコレクタ領域となるNウェル拡散層51上のゲート酸化膜を剥離し、内部ベース領域となるP型拡散領域52を、まず低ドーズB⁺注入により形成した後、A⁺又はPドープポリシリコン膜52を堆積し、MOSトランジスタのゲート電極と同時に加工してエミッタ領域の一部となるエミッタ電極53を形成する。この後、前述した方法によりポリシリコンのエミッタ電極53の側壁にCVD酸化膜54を残存させ、PMOSトランジスタのP⁺型ソース、ドレイン領域の形成に用いた高ドーズBF₂⁺イオン注入、その後の熱工程によりP⁺型外部ベース領域55がエミッタ電極53か

らP型内部ベース領域52中にA⁺又はPが拡散して形成され、N⁺型エミッタ領域56に接せず、かつセルフアラインで作られるため、ベース抵抗r_{bb'}が小さい高導バイポーラNPNトランジスタが実現される。

では、第1図の製造工程を示す断面図に従ってこの発明の一実施例を詳細に説明する。

まず、第1図(a)に示す工程において、面方位(100)、比抵抗 $20 \sim 30 \Omega\text{-cm}$ のP⁻型シリコン基板20に、選択的に $\rho_s \sim 20 \Omega/\square$ のN⁺型埋込拡散領域21を設けた後、厚さ $2.0 \mu\text{m}$ 、比抵抗 $1 \sim 2 \Omega\text{-cm}$ のP型エピタキシャル層22を成長させる。次に、PMOS、NPNバイポーラトランジスタを形成する箇所に $x_j = 2.5 \mu\text{m}$ 、 $\rho_s \sim 2 \text{ k}\Omega/\square$ のNウェル拡散層23を設けた後、厚さ $0.8 \mu\text{m}$ のフィールド酸化膜24を形成する。続いて、コレクタ抵抗を低減するため、N⁺型埋込拡散領域21に連するよう、 $\rho_s = 20 \sim 30 \Omega/\square$ の深いN⁺型拡散領域25を形成する。

第1図(b)に示す工程において、ゲート酸化膜と

なる厚さ 300 \AA の熱酸化膜26を形成し、B⁺を 40 KeV にて $5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2}$ イオン注入して熱処理を行ない拡散深さ $x_j \sim 0.5 \mu\text{m}$ のP型内部ベース領域27上の熱酸化膜26を剥離して厚さ $0.4 \mu\text{m}$ のポリシリコン膜28を堆積し、A⁺をポリシリコン膜28中に $5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ イオン注入する。

第1図(c)に示す工程において、前記ポリシリコン膜28をRIE法にてパターニングしてNMOS、PMOSのゲート電極28₁、28₂、エミッタ電極28₃を形成した後、ゲート電極、エミッタ電極の周囲、露出しているP型内部ベース領域27の表面に熱酸化膜29を形成する。この時、エミッタ電極からP⁻型内部ベース領域中にA⁺が高濃度に拡散されて $\rho_s \sim 30 \Omega/\square$ 、 $x_j \sim 0.15 \mu\text{m}$ のN⁺型エミッタ領域30が形成される。続いて、NMOS及びPMOSトランジスタの信頼性を確保するため、NMOS及びPMOSトランジスタ形成箇所にそれぞれP⁺及びB⁺を 50 KeV にて $1 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2}$ イオン注入して高耐圧構造を形成する。この後、厚さ $0.4 \mu\text{m}$ のCVD

酸化膜31を堆積する。

第1図(d)に示す工程において、前記CVD酸化膜31をRIE法にてエッチバックしてエミッタ電極及びMOSトランジスタのゲート電極の側壁にCVD酸化膜31を残存させる。続いて、NMOSトランジスタのソース、ドレイン領域形成のため A_{s}^{+} を40 KeVにて $5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ 、PMOSトランジスタのソース、ドレイン領域及びNPNバイポーラトランジスタの外部ベース領域形成のため BF_3^{+} を40 KeVにて $5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ イオン注入した後、熱処理を行ないイオン注入層を電気的に活性として、NMOSトランジスタの $x_1 \sim 0.4 \mu$ 程度の N^{+} 領域及び N^{-} 領域から成るソース及びドレイン領域32、32'、PMOSトランジスタの $x_1 \sim 0.4 \mu$ 程度の P^{+} 領域及び P^{-} 領域から成るソース及びドレイン領域33、33'、NPNバイポーラトランジスタの $x_1 \sim 0.2 \mu$ の P^{+} 型外部ベース領域34が形成される。

最後に、第2図(a)に示す工程において、厚さ1 μm のパッシベーション膜35を堆積して、コン

様々変形実施可能なことは勿論である。

〔発明の効果〕

以上述べたこの発明によれば、エミッタ電極の側壁に酸化膜によってサイドウォールを設けるようにしたので、これをスペーサとして外部ベース領域をエミッタ領域に対してセルフアラインで形成することができ、エミッタ領域下のベース抵抗を小さくすることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例の製造工程を示す断面図、第2図は一実施例の概略を説明するため示す断面図、第3図は従来のBI-CMOS半導体装置の製造方法の一例を示す断面図である。

20... P^{-} 型シリコン基板、31... N^{+} 型埋込拡散領域、22... P 型エピタキシャル層、23... N ウェル拡散層、24...フィールド酸化膜、25... N^{+} 型拡散領域、26...熱酸化膜、27... P 型内部ベース領域、28...ポリシリコン膜、29...熱酸化膜、30... N^{+} 型エミッタ領域、31...CVD酸化膜、32、32'、33、33'...ソース及びド

レイン領域、34... P^{+} 型外部ベース領域、35...パッシベーション膜、36...アルミニウム-シリコン電極。

この実施例によれば、MOSTRのゲート電極28、28'、側壁酸化膜31をバイポーラトランジスタのエミッタ電極28、の側壁にも残存させサイドウォールを形成することにより、このサイドウォールをスペーサとして P^{+} 型外部ベースを N^{+} 型エミッタ領域30にセルフアラインで形成することができるため、高速動作に適したBI-CMOS半導体装置を実現することができる。

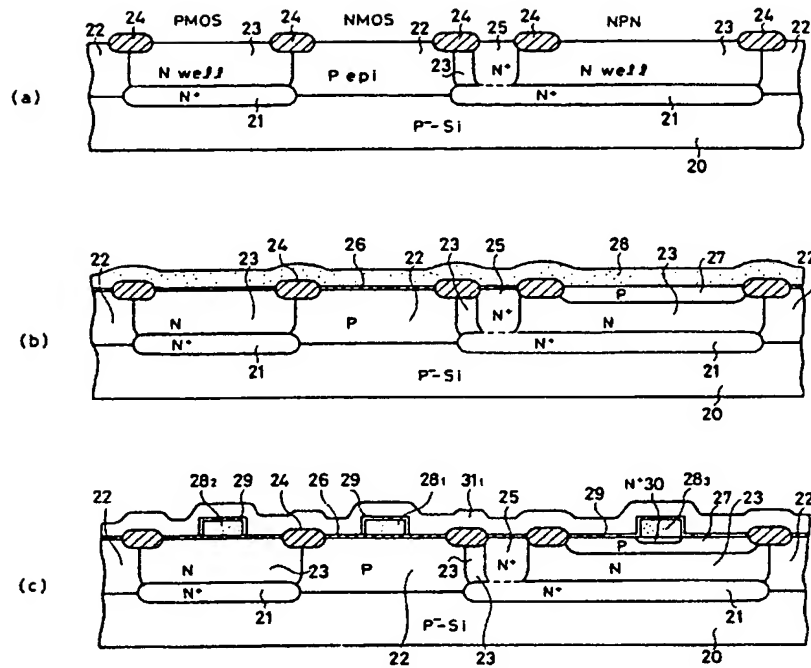
なおこの発明は、先の実施例2に限定されるものではない。

例えば、先の実施例においては、ゲート電極、エミッタ電極共に A_{s} ドープドポリシリコン膜を使用する場合を説明したが、ゲート電極として P ドープドポリシリコン膜を用いてもよい。更に、 N^{+} 型エミッタ領域をフィールド酸化膜に接してあるいは接しないように形成しても本発明は実施できる。

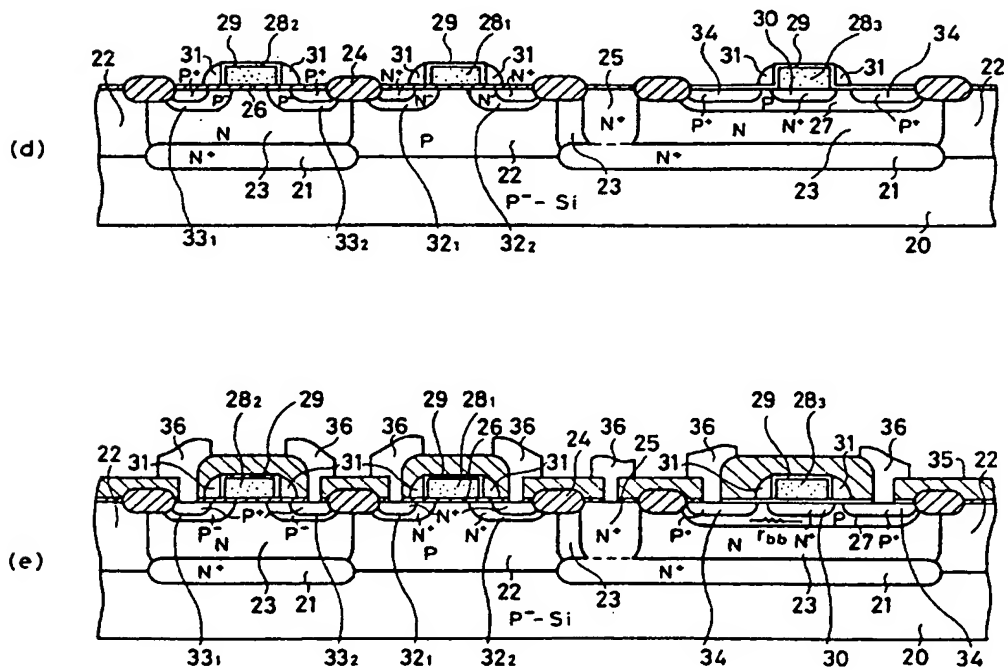
この他にも発明の要旨を逸脱しない範囲で種々

変形実施可能なことは勿論である。

出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦



第 1 図



第 1 図

